

6A 高速功率 MOSFET 驱动器

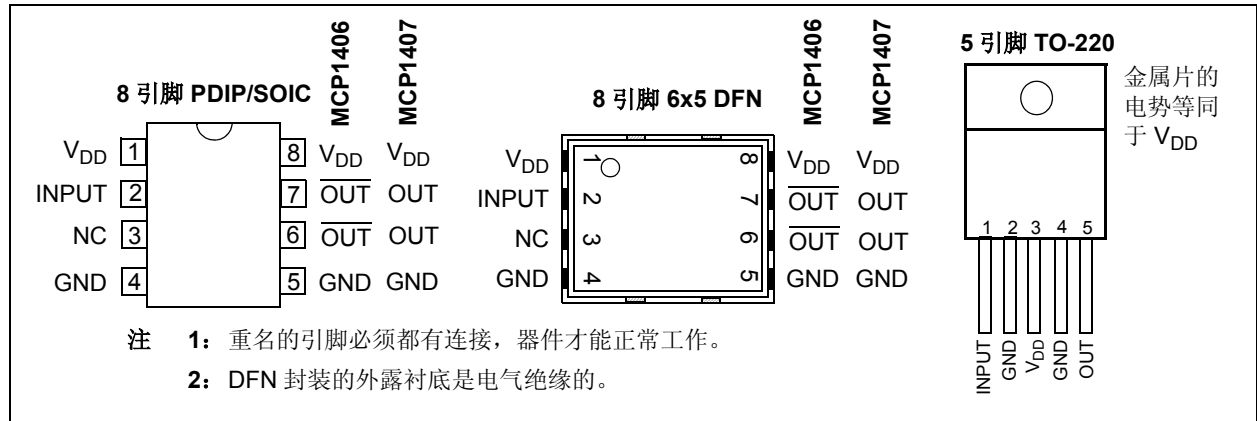
特性

- 高峰值输出电流：6.0A（典型值）
- 输出级具有低的贯通 / 导通交叉电流
- 宽输入电源电压范围：
 - 4.5V 至 18V
- 高容性负载驱动能力：
 - 20 ns 内驱动 2500 pF
 - 40 ns 内驱动 6800 pF
- 延迟时间短：40 ns（典型值）
- 匹配的上升 / 下降时间
- 低电源电流：
 - 对于逻辑 1 输入 - 130 μ A（典型值）
 - 对于逻辑 0 输入 - 35 μ A（典型值）
- 栓锁保护：能够承受 1.5A 反向电流
- 逻辑输入能够承受最高 5V 的负输入
- 与 TC4420/TC4429 器件的引脚兼容
- 节省空间的 8 引脚 SOIC 和 PDIP，以及 8 引脚 6x5 DFN 封装

应用

- 开关式电源
- 脉冲变压器驱动
- 线路驱动器
- 马达和螺线管驱动

封装类型



概述

MCP1406/07 系列器件是单路缓冲器 /MOSFET 驱动器，具有 6A 的峰值输出电流驱动能力、更低的导通电流、匹配的上升 / 下降时间和传输时延。这些器件是早先 TC4420/TC4429 MOSFET 驱动器的改进型版本，且引脚完全兼容

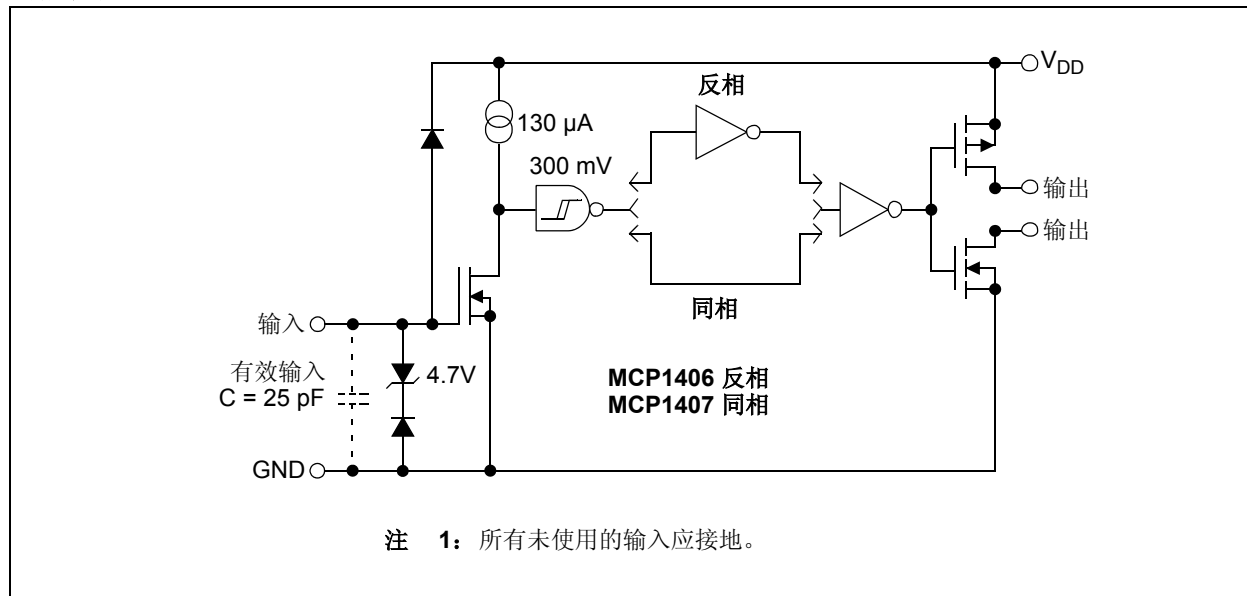
MCP1406/07 MOSFET 驱动器能够在 20 ns 之内轻松地对 2500 pF 的栅极电容进行充 / 放电。在开、关状态下，器件都具有足够低的阻抗，确保 MOSFET 的预期状态即使发生大的瞬态事件也不会受到影响。MCP1406/07 输入可以直接用 TTL 或 CMOS（3V 至 18V）电平驱动。

只要在其功率和电压额定范围内，任何情况下都不会使这些器件闭锁。当接地引脚噪声尖峰的幅度（任意方向）小于等于 5V 时，这些器件不会损坏。所有引脚都被充分地保护，能承受最高 4 kV 的静电放电（Electrostatic Discharge, ESD）。

MCP1406/07 单输出 6A MOSFET 驱动器系列提供表面贴装和通孔封装两种形式，工作温度的额定范围均为 -40°C 至 +125°C，特别适用于宽温度范围的应用。

MCP1406/07

功能框图 (1)



1.0 电气特性

绝对最大值 †

电源电压.....	+20V
输入电压.....	($V_{DD} + 0.3V$) 至 ($GND - 5V$)
输入电流 ($V_{IN} > V_{DD}$).....	50 mA

† 注：如果器件的工作条件超过“绝对最大值”列出的范围，就可能会对器件造成永久性损坏。上述值仅为运行条件极大值，我们建议不要使器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在最大额定值条件下，其稳定性会受到影响。

直流特性

电气规范：除非另外声明，否则所有参数均适用于 $T_A = +25^\circ\text{C}$, $4.5V \leq V_{DD} \leq 18V$ 。						
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
输入						
逻辑 1, 高输入电压	V_{IH}	2.4	1.8	—	V	
逻辑 0, 低输入电压	V_{IL}	—	1.3	0.8	V	
输入电流	I_{IN}	-10	—	10	μA	$0V \leq V_{IN} \leq V_{DD}$
输入电压	V_{IN}	-5	—	$V_{DD}+0.3$	V	
输出						
高输出电压	V_{OH}	$V_{DD} - 0.025$	—	—	V	DC 测试
低输出电压	V_{OL}	—	—	0.025	V	DC 测试
输出电阻, 高	R_{OH}	—	2.1	2.8	Ω	$I_{OUT} = 10 \text{ mA}$, $V_{DD} = 18V$
输出电阻, 低	R_{OL}	—	1.5	2.5	Ω	$I_{OUT} = 10 \text{ mA}$, $V_{DD} = 18V$
峰值输出电流	I_{PK}	—	6	—	A	$V_{DD} = 18V$ (注 2)
连续输出电流	I_{DC}	1.3			A	注 2 和注 3
栓锁保护能够承受的反向电流	I_{REV}	—	1.5	—	A	占空比 $\leq 2\%$, $t \leq 300 \mu\text{s}$
开关时间 (注 1)						
上升时间	t_R	—	20	30	ns	图 4-1 和图 4-2 $C_L = 2500 \text{ pF}$
下降时间	t_F	—	20	30	ns	图 4-1 和图 4-2 $C_L = 2500 \text{ pF}$
延迟时间	t_{D1}	—	40	55	ns	图 4-1 和图 4-2
延迟时间	t_{D2}	—	40	55	ns	图 4-1 和图 4-2
电源						
电源电压	V_{DD}	4.5	—	18.0	V	
电源电流	I_S	—	130	250	μA	$V_{IN} = 3V$
	I_S	—	35	100	μA	$V_{IN} = 0V$

- 注 1：由设计确保开关时间。
 注 2：经过器件特性测试，未经生产测试。
 注 3：仅适用于 AT 和 MF 封装， $T_A = +25^\circ\text{C}$ 。

MCP1406/07

直流特性（整个工作温度范围）

电气规范：除非另外声明，否则所有参数均适用于整个工作温度范围，且 $4.5V \leq V_{DD} \leq 18V$ 。						
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
输入						
逻辑 1，高输入电压	V_{IH}	2.4	—	—	V	
逻辑 0，低输入电压	V_{IL}	—	—	0.8	V	
输入电流	I_{IN}	-10	—	+10	μA	$0V \leq V_{IN} \leq V_{DD}$
输入电压	V_{IN}	-5	—	$V_{DD}+0.3$	V	
输出						
高输出电压	V_{OH}	$V_{DD} - 0.025$	—	—	V	DC 测试
低输出电压	V_{OL}	—	—	0.025	V	DC 测试
输出电阻，高	R_{OH}	—	3.0	5.0	Ω	$I_{OUT} = 10 \text{ mA}, V_{DD} = 18V$
输出电阻，低	R_{OL}	—	2.3	5.0	Ω	$I_{OUT} = 10 \text{ mA}, V_{DD} = 18V$
开关时间（注 1）						
上升时间	t_R	—	25	40	ns	图 4-1 和图 4-2 $C_L = 2500 \text{ pF}$
下降时间	t_F	—	25	40	ns	图 4-1 和图 4-2 $C_L = 2500 \text{ pF}$
延迟时间	t_{D1}	—	50	65	ns	图 4-1 和图 4-2
延迟时间	t_{D2}	—	50	65	ns	图 4-1 和图 4-2
电源						
电源电压	V_{DD}	4.5	—	18.0	V	
电源电流	I_S	—	200	500	μA	$V_{IN} = 3V$
		—	50	150		$V_{IN} = 0V$

注 1：由设计确保开关时间。

温度特性

电气规范：除非另外声明，否则所有参数均适用于 $4.5V \leq V_{DD} \leq 18V$ 。						
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
温度范围						
规定温度范围	T_A	-40	—	+125	$^{\circ}C$	
最大结温	T_J	—	—	+150	$^{\circ}C$	
储存温度范围	T_A	-65	—	+150	$^{\circ}C$	
封装热阻						
热阻，8 引脚 6x5 DFN	θ_{JA}	—	33.2	—	$^{\circ}C/W$	典型四层板，有连接到地电位层的导孔
热阻，8 引脚 PDIP	θ_{JA}	—	125	—	$^{\circ}C/W$	
热阻，8 引脚 SOIC	θ_{JA}	—	155	—	$^{\circ}C/W$	
热阻，5 引脚 TO-220	θ_{JA}	—	71	—	$^{\circ}C/W$	

2.0 典型性能曲线

注： 以下图表来自有限数量样本的统计结果，仅供参考。所列出的性能特性未经测试，不做任何担保。一些图表中列出的数据可能超出规定的工作范围（例如，超出了规定的电源电压范围），因而不在此担保范围内。

注： 除非另外声明，否则所有参数均适用于 $T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 $4.5\text{V} \leq V_{DD} \leq 18\text{V}$ 。

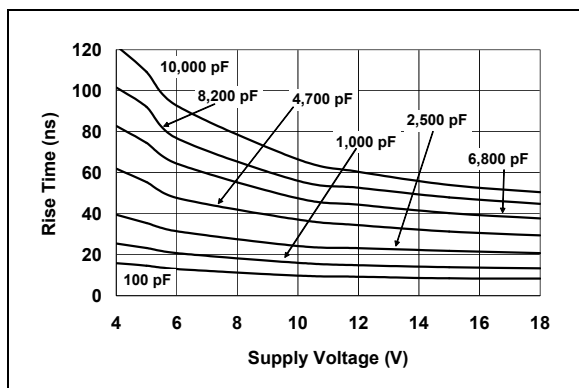


图 2-1: 上升时间—电源电压关系曲线

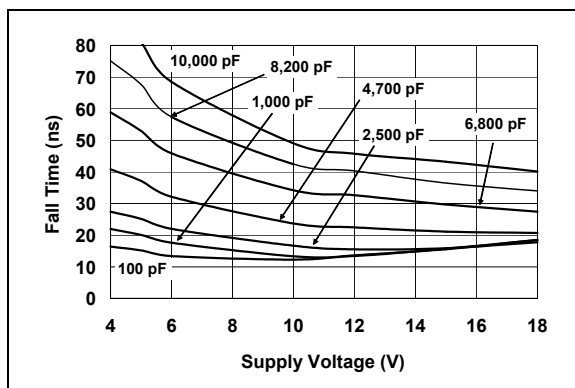


图 2-4: 下降时间—电源电压关系曲线

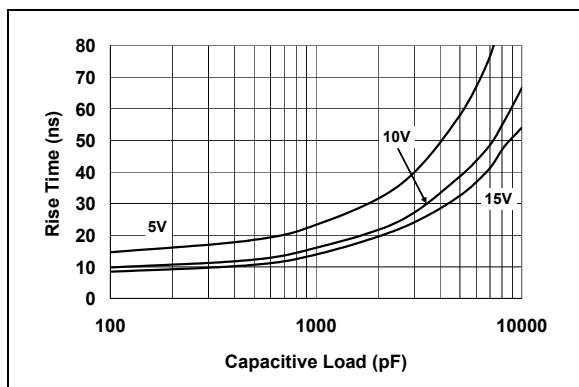


图 2-2: 上升时间—容性负载关系曲线

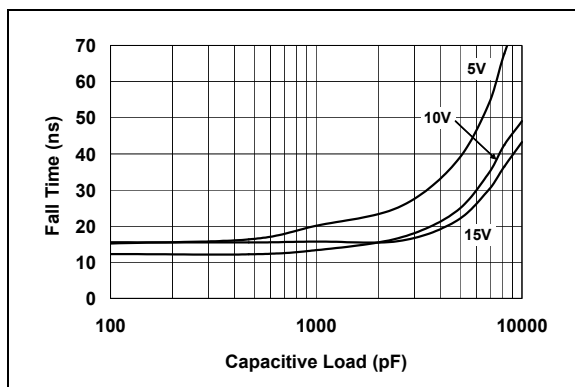


图 2-5: 下降时间—容性负载关系曲线

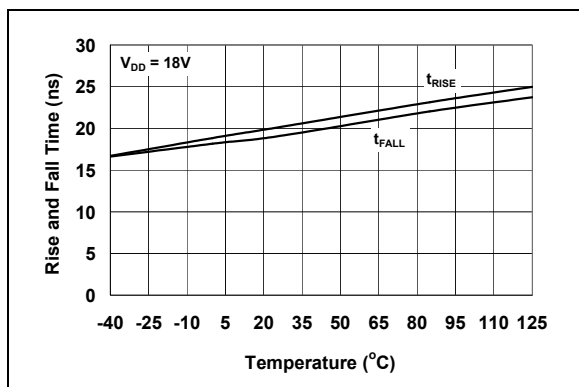


图 2-3: 上升和下降时间—温度关系曲线

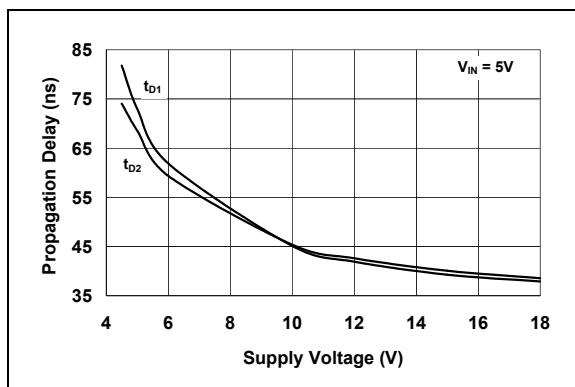


图 2-6: 传输时延—电源电压关系曲线

MCP1406/07

典型性能曲线 (续)

注: 除非另外声明, 否则所有参数均适用于 $T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 $4.5\text{V} \leq V_{DD} \leq 18\text{V}$ 。

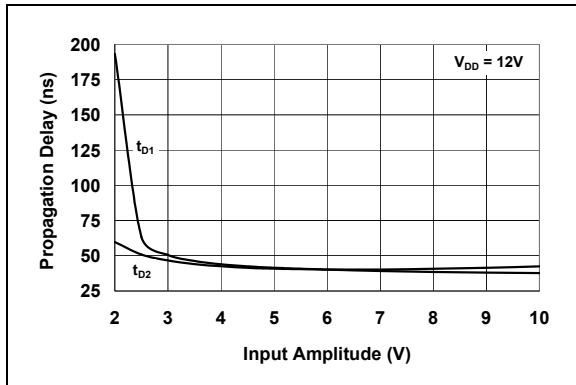


图 2-7: 传输延迟—输入幅度关系曲线

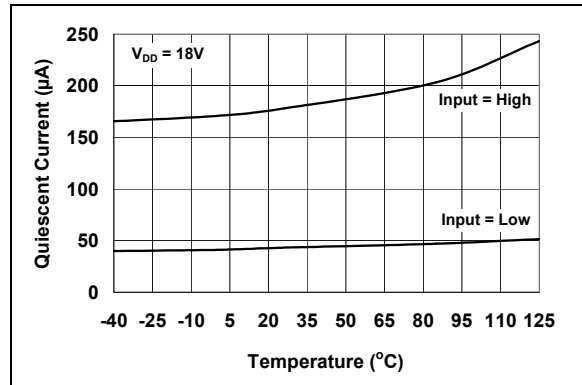


图 2-10: 静态电流—温度关系曲线

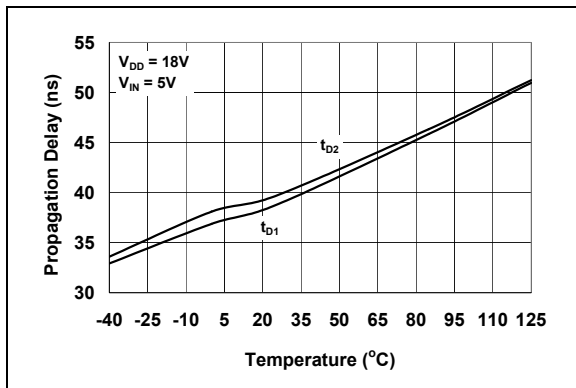


图 2-8: 传输延迟—温度关系曲线

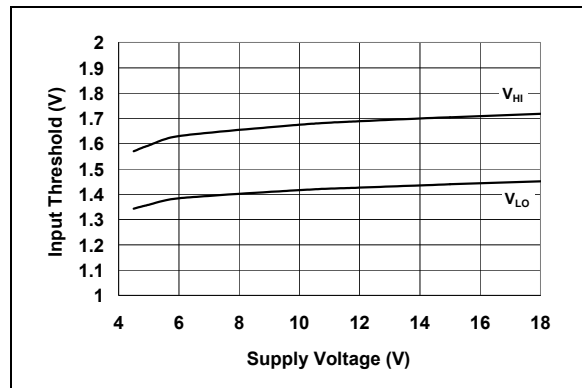


图 2-11: 输入门限电压—电源电压关系曲线

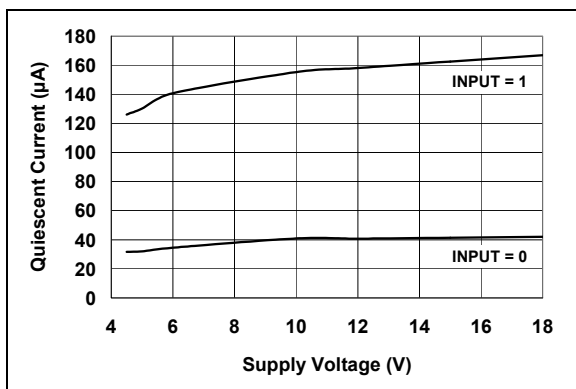


图 2-9: 静态电流—电源电压关系曲线

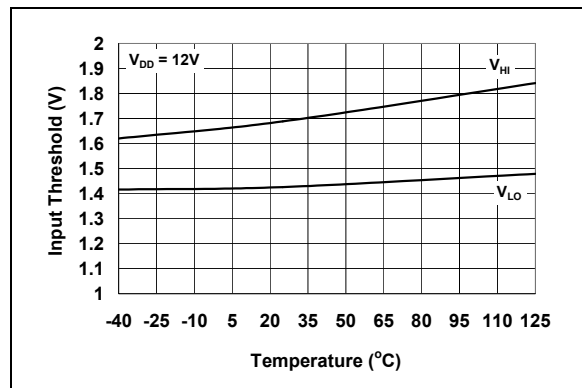


图 2-12: 输入门限电压—温度关系曲线

典型性能曲线 (续)

注: 除非另外声明, 否则所有参数均适用于 $T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 $4.5\text{V} \leq V_{DD} \leq 18\text{V}$ 。

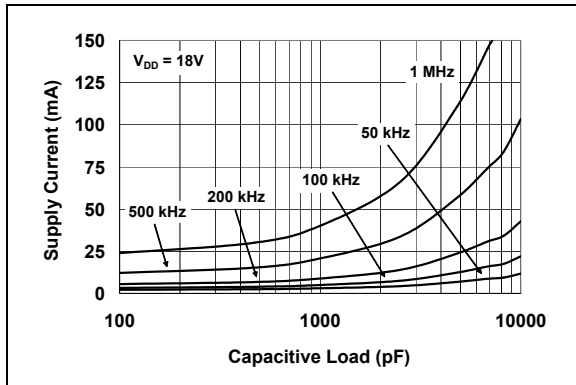


图 2-13: 电源电流—容性负载关系曲线

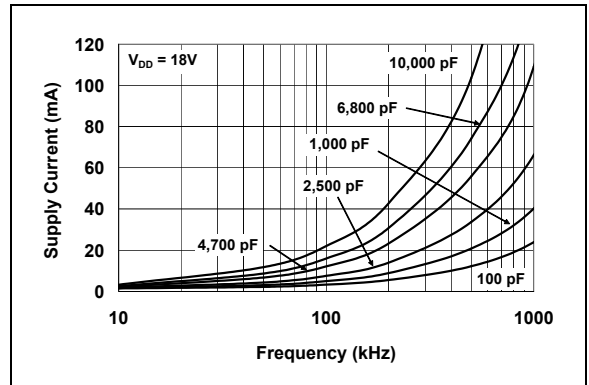


图 2-16: 电源电流—频率关系曲线

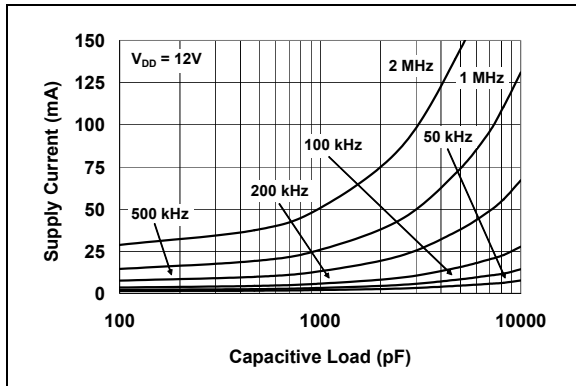


图 2-14: 电源电流—容性负载关系曲线

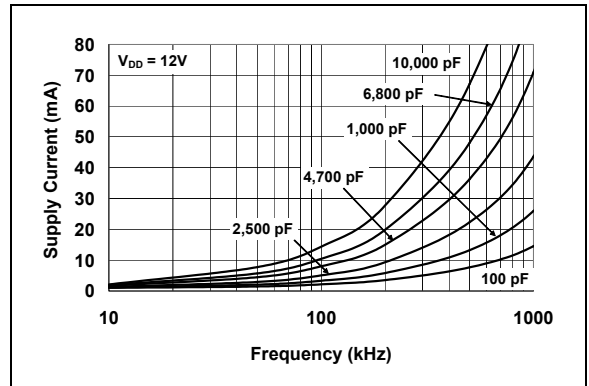


图 2-17: 电源电流—频率关系曲线

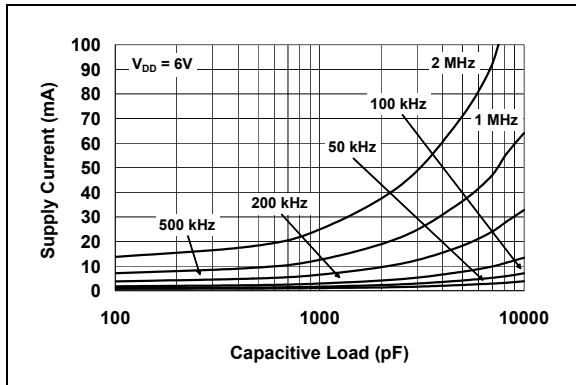


图 2-15: 电源电流—容性负载关系曲线

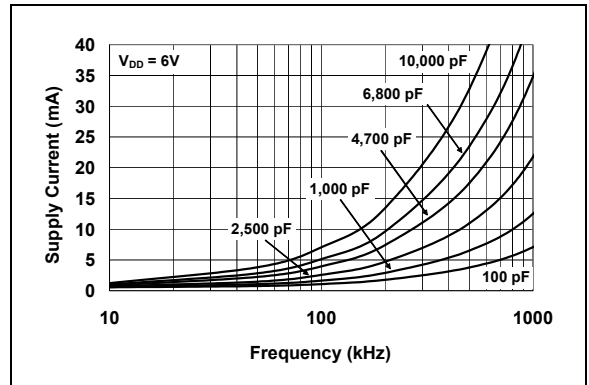


图 2-18: 电源电流—频率关系曲线

MCP1406/07

典型性能曲线 (续)

注: 除非另外声明, 否则所有参数均适用于 $T_A = +25^\circ\text{C}$ 且 $4.5\text{V} \leq V_{DD} \leq 18\text{V}$ 。

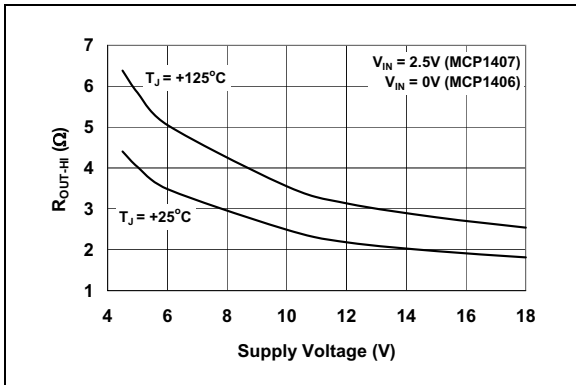


图 2-19: 输出电阻 (输出高电平) — 电源电压关系曲线

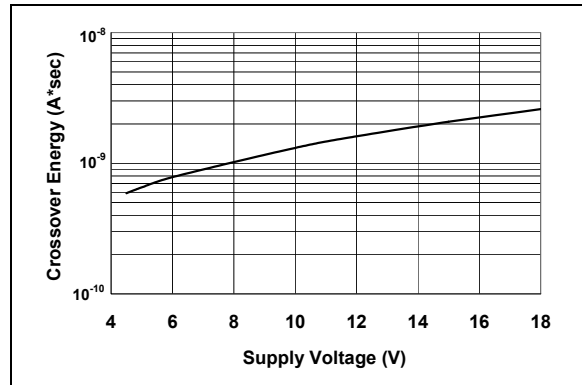


图 2-21: 交越能量—电源电压关系曲线

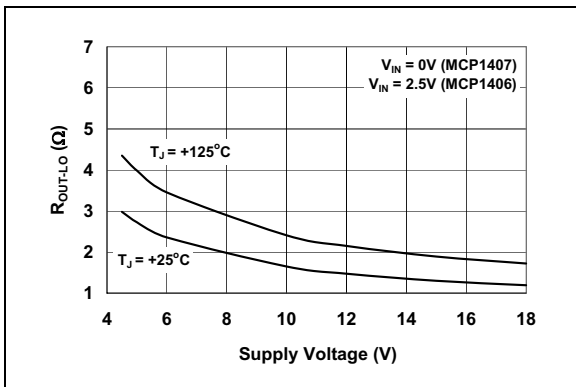


图 2-20: 输出电阻 (输出低电平) — 电源电压关系曲线

3.0 引脚说明

表 3-1 列出了引脚的说明。

表 3-1: 引脚功能表⁽¹⁾

8 引脚 PDIP 和 SOIC	8 引脚 DFN	5 引脚 TO-220	符号	说明
1	1	—	V_{DD}	电源输入
2	2	1	INPUT	控制输入
3	3	—	NC	无连接
4	4	2	GND	地
5	5	4	GND	地
6	6	5	OUTPUT	CMOS 推挽输出
7	7	—	OUTPUT	CMOS 推挽输出
8	8	3	V_{DD}	电源输入
—	PAD	—	NC	外露的金属衬底
—	—	TAB	V_{DD}	金属片的电势为 V_{DD}

注 1: 重名的引脚必须都有连接, 器件才能正常工作。

3.1 电源输入 (V_{DD})

V_{DD} 是 MOSFET 驱动器的偏置电源输入, 电压范围为 4.5V 至 18V。该输入必须通过一个本地去耦电容连接到地。该旁路电容为负载的峰值驱动电流提供了一条本地低阻抗路径。

3.2 控制输入 (INPUT)

MOSFET 驱动器输入为 TTL/CMOS 兼容的高阻抗输入。这些输入在高低输入电平间有迟滞, 从而可被缓慢上升和下降的信号驱动, 同时提高了噪声抑制能力。

3.3 地 (GND)

地是器件的接地返回引脚。接地引脚应与偏置电源返回点间采用低阻抗连接。当容性负载放电时, 高峰值电流会流出接地引脚。

3.4 CMOS 推挽输出 (OUTPUT)

输出是 CMOS 推挽输出, 能够提供 6A 的峰值电流 ($V_{DD} = 18V$)。低输出阻抗确保即使发生大瞬变事件的情况下外部 MOSFET 的栅极仍处于期望的状态。这些输出也可以承受 1.5A 的反向栓锁电流。

3.5 外露金属衬底

DFN 封装裸露的金属衬底在内部没有与任何电势相连。因此, 它可以连接到地电位层或者印刷电路板的其他敷铜层上, 以帮助器件散热。

3.6 TO-220 金属片

TO-220 封装的金属片连接到器件的 V_{DD} 电势点。该金属片不能作为 MCP1406/07 的 V_{DD} 连接点。应该通过 TO-220 封装的电源输入引脚提供 V_{DD} 电压。

MCP1406/07

4.0 应用信息

4.1 一般信息

MOSFET 驱动器为高速、大电流器件，其用来为外部 MOSFET 或 IGBT 的栅极电容提供高峰值充电电流。在高频开关电源中，PWM 控制器可能无法直接驱动功率 MOSFET。此时，诸如 MCP1406/07 系列等 MOSFET 驱动器就可被用来提供额外的驱动电流。

4.2 MOSFET 驱动器时序

MOSFET 驱动器从完全关断状态过渡到完全导通状态的能力由驱动器的上升时间 (t_R)、下降时间 (t_F) 和传输时延 (t_{D1} 和 t_{D2}) 表征。MCP1406/07 系列器件可使这个过渡时间非常快。图 4-1 和图 4-2 显示了验证 MCP1406/07 时序的测试电路和时序波形。

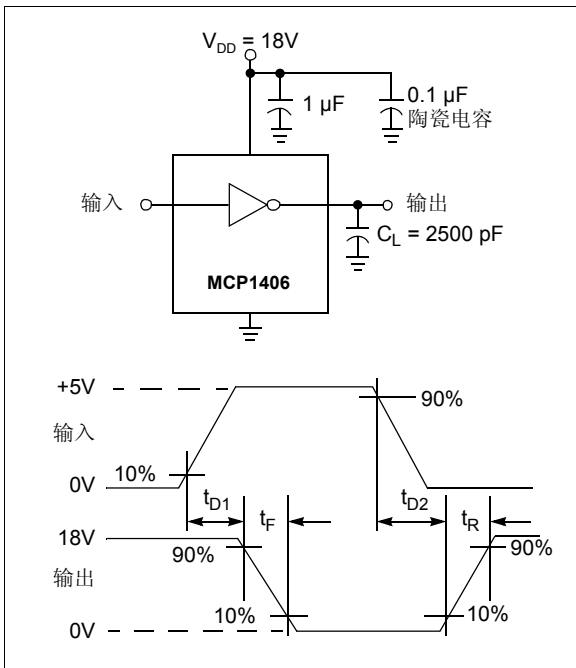


图 4-1: 反相驱动器时序波形

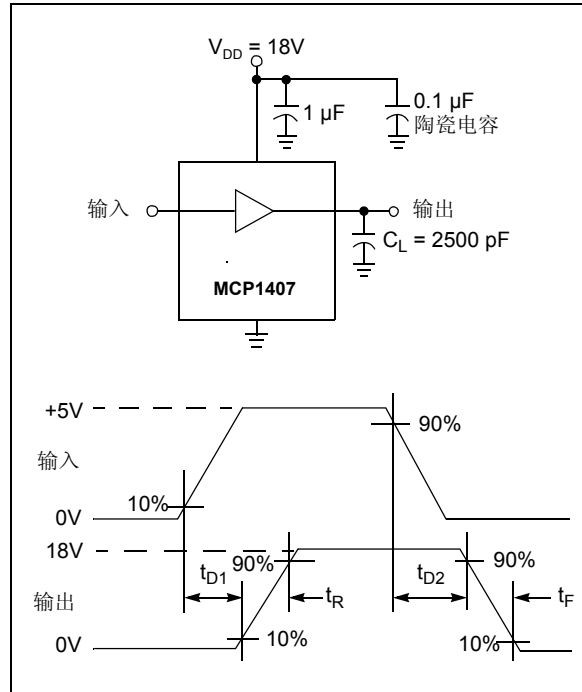


图 4-2: 同相驱动器时序波形

4.3 去耦电容

强烈建议在使用 MOSFET 驱动器时仔细布线并使用去耦电容。对容性负载进行快速充 / 放电时需要很高的电流。例如，在 20 ns 内将 2500 pF 的负载充电到 18V 需要 2.25A 的电流。

在宽频率范围，低电源阻抗条件下使用 MOSFET 驱动器时，建议在驱动器的 V_{DD} 和 GND 间并联摆放一个陶瓷电容和一个低 ESR 的薄膜电容。应该在引脚 1（或 8）和 4（或 5）间摆放 1.0 μ F 的低 ESR 薄膜电容和 0.1 μ F 的陶瓷电容。这些电容应尽可能靠近驱动器摆放，以减小电路板的寄生参数并为所需电流提供本地电流源。

4.4 PCB 布板考虑

为达到器件正常工作和设计可靠性，大电流和快速开关电路中正确的 PCB 布板显得尤为重要。采用在 MOSFET 栅极驱动信号下使用地电位层或地走线，将模拟地和功率地分开，并使用本地驱动器去耦技术，从而减小 PCB 走线环路面积和感抗。

MCP1406/07 器件 均有两个 V_{DD} 、两个 OUTPUT 和两个 GND 引脚。要使器件正常工作，同名的两个引脚都要使用。这将降低走线电感，同时通过正确的去耦，可以帮助将电路的振铃减至最小。

在 MCP1406/07 器件下方设置地电位层一方面可以屏蔽辐射噪声，同时也可以散热，帮助将器件内部由于耗能产生的热量散掉。

4.5 功耗

MOSFET 驱动器内部的总功耗由三个独立的部分组成。

$$P_T = P_L + P_Q + P_{CC}$$

其中：

P_T = 总功耗

P_L = 负载功耗

P_Q = 静态功耗

P_{CC} = 工作功耗

4.5.1 容性负载功耗

容性负载产生的功耗与频率、总容性负载和电源电压成直接函数关系。MOSFET 驱动器驱动容性负载的一个完整的充 / 放电周期所消耗的功率为：

$$P_L = f \times C_T \times V_{DD}^2$$

其中：

f = 开关频率

C_T = 总负载电容

V_{DD} = MOSFET 驱动器电源电压

4.5.2 静态功耗

与汲取的静态电流相关的功耗取决于输入引脚的状态。MCP1406/07 器件在两个输入均为高电平时汲取 0.13 mA（典型值）的静态电流为，在两个输入均为低电平时汲取 0.035 mA（典型值）的静态电流。静态功耗为：

$$P_Q = (I_{QH} \times D + I_{QL} \times (1 - D)) \times V_{DD}$$

其中：

I_{QH} = 高电平状态下的静态电流

D = 占空比

I_{QL} = 低电平状态下的静态电流

V_{DD} = MOSFET 驱动器的电源电压

4.5.3 工作功耗

工作功耗发生在每次 MOSFET 驱动器输出变化过程中，因为此时输出级的两个 MOSFET 在很短的时间周期内同时导通。这个交越电流导致的功耗描述如下：

$$P_{CC} = CC \times f \times V_{DD}$$

其中：

CC = 交越电流（A*sec）

f = 开关频率

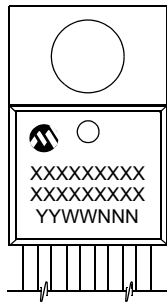
V_{DD} = MOSFET 驱动器的电源电压

MCP1406/07

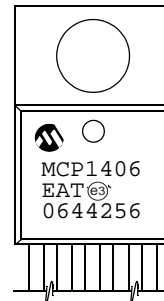
5.0 封装信息

5.1 封装标识信息（未按比例绘制）

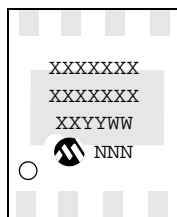
5 引脚 TO-220



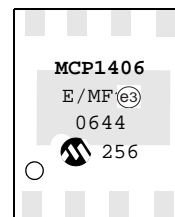
示例



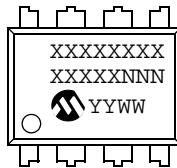
8 引脚 DFN



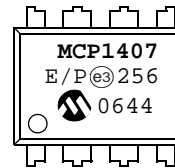
示例



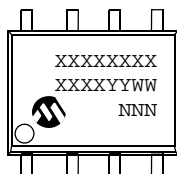
8 引脚 PDIP (300 mil)



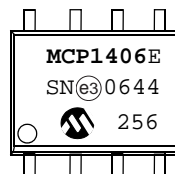
示例



8 引脚 SOIC (150 mil)



示例



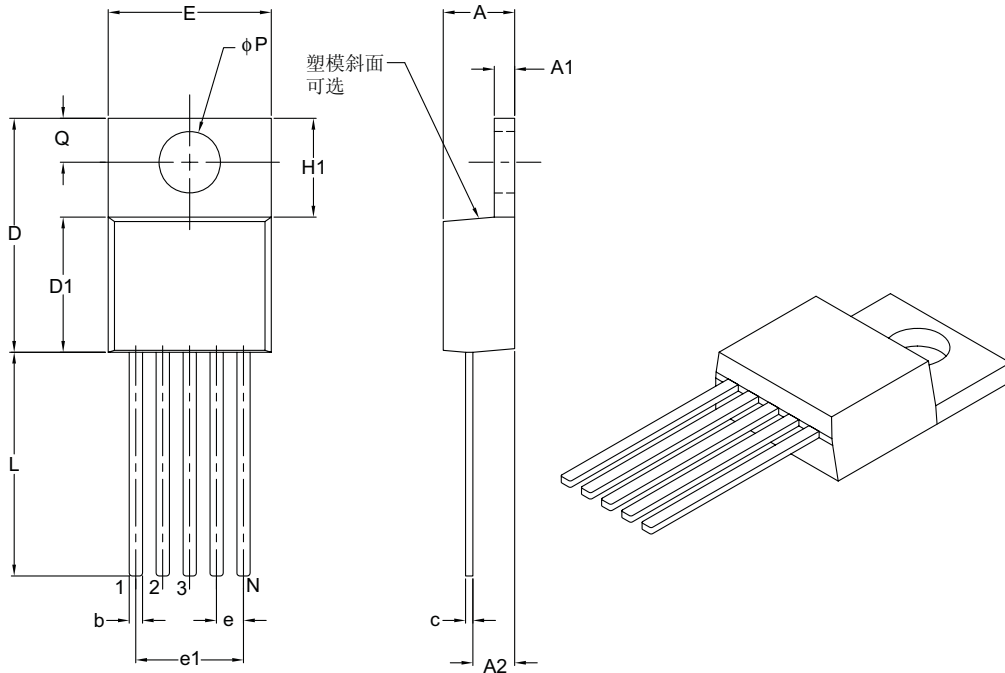
图注:

- XX...X 客户指定信息
- Y 年份代码（公历年份的最后一位数字）
- YY 年份代码（公历年份的最后两位数字）
- WW 星期代码（一月的第一个星期的代码为“01”）
- NNN 按字母数字排序的追踪代码
- (e3) 雾锡（Sn）的 JEDEC 无铅标识
- * 表示无铅封装。JEDEC 无铅标识 ((e3)) 标示于此种封装的外包装上。

注: Microchip 元器件编号如果无法在同一行内完整标注，将换行标出，因此会限制客户指定信息的可用字符数。

5 引脚塑封晶体管外形 (AT) (TO-220)

注： 最新的封装图，请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



尺寸范围	单位	英寸		
		最小	正常	最大
引脚数	N	5		
引脚间距	e	.067 BSC		
引脚总间距	e1	.268 BSC		
总高度	A	.140	—	.190
总宽度	E	.380	—	.420
总长度	D	.560	—	.650
塑模封装长度	D1	.330	—	.355
超出塑模散热片长度	H1	.204	—	.293
散热片厚度	A1	.020	—	.055
孔中心到散热片上边沿距离	Q	.100	—	.120
孔直径	φP	.139	—	.156
引脚长度	L	.482	—	.590
基座背面到引脚距离	A2	.080	—	.115
引脚厚度	c	.012	—	.025
引脚宽度	b	.015	.027	.040

注：

1. 尺寸D和E1不包括塑模毛边和突起。塑模每侧的毛边和突起不得超过0.005英寸。

2. 尺寸和公差遵循 ASME Y14.5M。

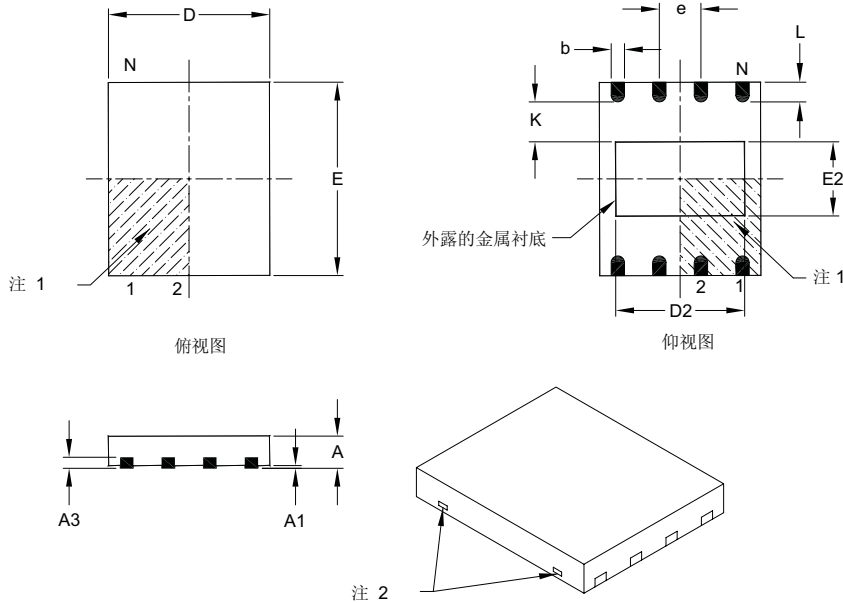
BSC: 基本尺寸。理论精确值，不包括公差。

Microchip Technology 图号 C04-036B

MCP1406/07

8 引脚塑封双列扁平无引脚封装 (MF) —— 主体 6x5 mm [DFN-S]

注： 最新的封装图，请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



尺寸范围	单位	毫米		
		最小	正常	最大
引脚数	N	8		
引脚间距	e	1.27 BSC		
总高度	A	0.80	0.85	1.00
悬空间隙	A1	0.00	0.01	0.05
触点厚度	A3	0.20 REF		
总长度	D	5.00 BSC		
总宽度	E	6.00 BSC		
外露衬底长度	D2	3.90	4.00	4.10
外露衬底宽度	E2	2.20	2.30	2.40
触点宽度	b	0.35	0.40	0.48
触点长度	L	0.50	0.60	0.75
触点到外露衬底距离	K	0.20	-	-

注：

1. 引脚1定位标记可能会有变化，但一定位于阴影区域内。
2. 封装两端可能有一个以上的外露系杆。
3. 该封装是切割分离的。
4. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

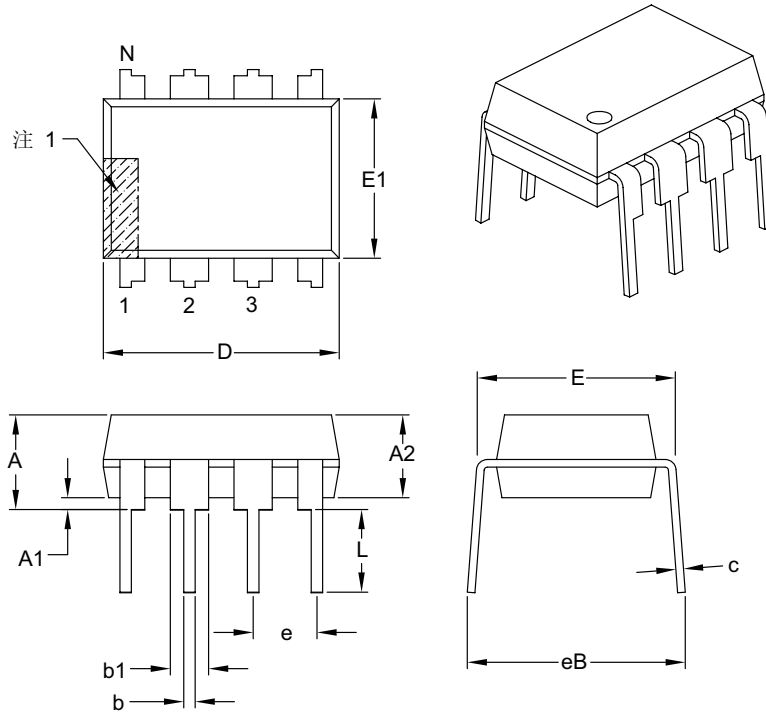
BSC: 基本尺寸。理论精确值，不含公差。

REF: 参考尺寸。通常不含公差，仅供参考。

Microchip Technology 图号C04-122B

8 引脚塑封双列直插式封装 (PA) —— 主体 300 mil (PDIP)

注： 最新的封装图，请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



尺寸范围	单位	英寸		
		最小	正常	最大
引脚数	N	8		
引脚间距	e	.100 BSC		
塑模顶部到定位平面距离	A	—	—	.210
塑模封装厚度	A2	.115	.130	.195
塑模底部到定位平面距离	A1	.015	—	—
肩到肩宽度	E	.290	.310	.325
塑模封装宽度	E1	.240	.250	.280
总长度	D	.348	.365	.400
引脚尖到定位平面距离	L	.115	.130	.150
引脚厚度	c	.008	.010	.015
引脚上部宽度	b1	.040	.060	.070
引脚下部宽度	b	.014	.018	.022
总引脚行间距 §	eB	—	—	.430

注：

1. 引脚1定位特性可能有变化，但一定位于阴影区域内。
2. § 重要特性。
3. 尺寸D和E1不包括塑模毛边和突起。塑模每侧的毛边和突起不得超过0.010英寸。
4. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

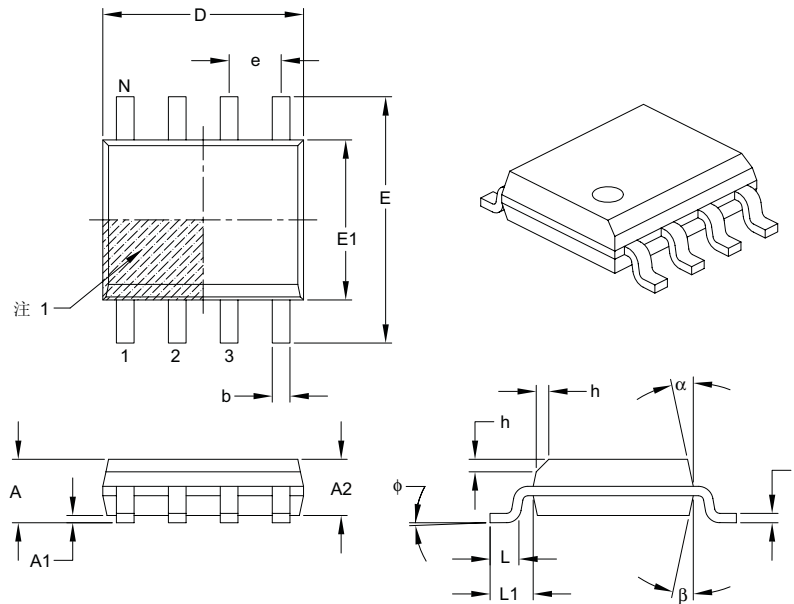
BSC：基本尺寸。理论精确值，不包括公差。

Microchip Technology 图号 C04-018B

MCP1406/07

8 引脚塑封窄条小型封装 (SN) —— 主体 150mil (SOIC)

注： 最新的封装图，请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



尺寸范围	单位	毫米		
		最小	正常	最大
引脚数	N	8		
引脚间距	e	1.27 BSC		
总高度	A	—	—	1.75
塑模封装厚度	A2	1.25	—	—
悬空间隙 §	A1	0.10	—	0.25
总宽度	E	6.00 BSC		
塑模封装宽度	E1	3.90 BSC		
总长度	D	4.90 BSC		
塑模斜面投影距离 (可选)	h	0.25	—	0.50
底脚长度	L	0.40	—	1.27
底脚投影距离	L1	1.04 REF		
底脚倾角	φ	0°	—	8°
引脚厚度	c	0.17	—	0.25
引脚宽度	b	0.31	—	0.51
塑模顶部锥度	α	5°	—	15°
塑模底部锥度	β	5°	—	15°

注：

1. 引脚1定位特性可能有变化，但一定位于阴影区域内。
2. § 重要特性。
3. 尺寸D和E1不包括塑模毛边和突起。塑模每侧的毛边和突起不得超过0.15 mm。
4. 尺寸和公差遵循ASME Y14.5M。

BSC: 基本尺寸。理论精确值，不包括公差。

REF: 参考尺寸。仅供参考，通常不包括公差。

Microchip Technology 图号 C04-057B

附录 A: 版本历史

版本 A (2006 年 12 月)

- 本数据手册的初始版本。

MCP1406/07

注:

产品标识体系

欲订货或获取价格、交货等信息，请与我公司生产或销售办事处联系。

器件编号	X	XX	XXX	示例:
器件	温度范围	封装	卷带式	
器件: MCP1406: 6A 高速反相 MOSFET 驱动器 MCP1406T: 6A 高速反相 MOSFET 驱动器 (卷带式) MCP1407: 6A 高速同相 MOSFET 驱动器 MCP1407T: 6A 高速同相 MOSFET 驱动器 (卷带式)	温度范围: E = - 40°C 至 +125°C	封装: * AT = 5 引脚 TO-220 MF = 8 引脚双列扁平无引脚 (主体 6x5 mm) PA = 8 引脚塑封 DIP (主体 300 mil) SN = 8 引脚塑封 SOIC (主体 150 mil) * 所有封装都是无铅封装。		a) MCP1406-E/MF: 6A 高速反相 MOSFET 驱动器, 8 引脚 DFN 封装 b) MCP1406-E/AT: 6A 高速反相 MOSFET 驱动器, 5 引脚 TO-220 封装 c) MCP1406-E/SN: 6A 高速反相 MOSFET 驱动器, 8 引脚 SOIC 封装 d) MCP1406-E/P: 6A 高速反相 MOSFET 驱动器, 8 引脚 PDIP 封装 e) MCP1406T-E/MF: 卷带式, 6A 高速反相 MOSFET 驱动器, 8 引脚 DFN 封装 f) MCP1406T-E/SN: 卷带式, 6A 高速反相 MOSFET 驱动器, 8 引脚 SOIC 封装 a) MCP1407-E/MF: 6A 高速同相 MOSFET 驱动器, 8 引脚 DFN 封装 b) MCP1407-E/AT: 6A 高速同相 MOSFET 驱动器, 5 引脚 TO-220 封装 c) MCP1407-E/SN: 6A 高速同相 MOSFET 驱动器, 8 引脚 SOIC 封装 d) MCP1407-E/P: 6A 高速同相 MOSFET 驱动器, 8 引脚 PDIP 封装 e) MCP1407T-E/MF: 卷带式, 6A 高速同相 MOSFET 驱动器, 8 引脚 DFN 封装 f) MCP1407T-E/SN: 卷带式, 6A 高速同相 MOSFET 驱动器, 8 引脚 SOIC 封装

MCP1406/07

注:

请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点:

- Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。
- Microchip 确信: 在正常使用的情况下, Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。
- 目前, 仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知, 所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。
- Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。
- Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是“牢不可破”的。

代码保护功能处于持续发展中。Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视为违反了《数字千年版权法案 (Digital Millennium Copyright Act)》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下, 能访问您的软件或其他受版权保护的成果, 您有权依据该法案提起诉讼, 从而制止这种行为。

提供本文档的中文版本仅为为了便于理解。请勿忽视文档中包含的英文部分, 因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为为您提供便利, 它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范, 是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保, 包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适用性或特定用途的适用性的声明或担保。Microchip 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命维持和/或生命安全应用, 一切风险由买方自负。买方同意在由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时, 会维护和保障 Microchip 免于承担法律责任, 并加以赔偿。在 Microchip 知识产权保护下, 不得暗或以其他方式转让任何许可证。

商标

Microchip 的名称和徽标组合、Microchip 徽标、Accuron、dsPIC、KEELOQ、KEELOQ 徽标、microID、MPLAB、PIC、PICmicro、PICSTART、PRO MATE、rPIC 和 SmartShunt 均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的注册商标。

AmpLab、FilterLab、Linear Active Thermistor、Migratable Memory、MXDEV、MXLAB、SEEVAL、SmartSensor 和 The Embedded Control Solutions Company 均为 Microchip Technology Inc. 在美国的注册商标。

Analog-for-the-Digital Age、Application Maestro、CodeGuard、dsPICDEM、dsPICDEM.net、dsPICworks、dsSPEAK、ECAN、ECONOMONITOR、FanSense、FlexROM、fuzzyLAB、In-Circuit Serial Programming、ICSP、ICEPIC、Mindi、MiWi、MPASM、MPLAB Certified 徽标、MPLIB、MPLINK、PICkit、PICDEM、PICDEM.net、PICLAB、PICtail、PowerCal、PowerInfo、PowerMate、PowerTool、REAL ICE、rLAB、Select Mode、Smart Serial、SmartTel、Total Endurance、UNI/O、WiperLock 和 ZENA 均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的商标。

SQTP 是 Microchip Technology Inc. 在美国的服务标记。

在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。

© 2007, Microchip Technology Inc. 版权所有。

**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
== ISO/TS 16949:2002 ==**

Microchip 位于美国亚利桑那州 Chandler 和 Tempe 与位于俄勒冈州 Gresham 的全球总部、设计和晶圆生产厂及位于美国加利福尼亚州和印度的设计中心均通过了 ISO/TS-16949:2002 认证。公司在 PIC[®] MCU 与 dsPIC[®] DSC、KEELOQ[®] 跳码器件、串行 EEPROM、单片机外设、非易失性存储器和模拟产品方面的质量体系流程均符合 ISO/TS-16949:2002。此外, Microchip 在开发系统的设计和生产方面的质量体系也已通过了 ISO 9001:2000 认证。



MICROCHIP

全球销售及服务中心

美洲

公司总部 Corporate Office
2355 West Chandler Blvd.
Chandler, AZ 85224-6199
Tel: 1-480-792-7200
Fax: 1-480-792-7277

技术支持:
<http://support.microchip.com>
网址: www.microchip.com

亚特兰大 Atlanta
Duluth, GA

Tel: 678-957-9614
Fax: 678-957-1455

波士顿 Boston
Westborough, MA
Tel: 1-774-760-0087
Fax: 1-774-760-0088

芝加哥 Chicago
Itasca, IL
Tel: 1-630-285-0071
Fax: 1-630-285-0075

达拉斯 Dallas
Addison, TX
Tel: 1-972-818-7423
Fax: 1-972-818-2924

底特律 Detroit
Farmington Hills, MI
Tel: 1-248-538-2250
Fax: 1-248-538-2260

科科莫 Kokomo
Kokomo, IN
Tel: 1-765-864-8360
Fax: 1-765-864-8387

洛杉矶 Los Angeles
Mission Viejo, CA
Tel: 1-949-462-9523
Fax: 1-949-462-9608

圣克拉拉 Santa Clara
Santa Clara, CA
Tel: 408-961-6444
Fax: 408-961-6445

加拿大多伦多 Toronto
Mississauga, Ontario,
Canada
Tel: 1-905-673-0699
Fax: 1-905-673-6509

亚太地区

亚太总部 Asia Pacific Office
Suites 3707-14, 37th Floor
Tower 6, The Gateway
Harbour City, Kowloon
Hong Kong
Tel: 852-2401-1200
Fax: 852-2401-3431

中国 - 北京
Tel: 86-10-8528-2100
Fax: 86-10-8528-2104

中国 - 成都
Tel: 86-28-8665-5511
Fax: 86-28-8665-7889

中国 - 福州
Tel: 86-591-8750-3506
Fax: 86-591-8750-3521

中国 - 香港特别行政区
Tel: 852-2401-1200
Fax: 852-2401-3431

中国 - 青岛
Tel: 86-532-8502-7355
Fax: 86-532-8502-7205

中国 - 上海
Tel: 86-21-5407-5533
Fax: 86-21-5407-5066

中国 - 沈阳
Tel: 86-24-2334-2829
Fax: 86-24-2334-2393

中国 - 深圳
Tel: 86-755-8203-2660
Fax: 86-755-8203-1760

中国 - 顺德
Tel: 86-757-2839-5507
Fax: 86-757-2839-5571

中国 - 武汉
Tel: 86-27-5980-5300
Fax: 86-27-5980-5118

中国 - 西安
Tel: 86-29-8833-7252
Fax: 86-29-8833-7256

台湾地区 - 高雄
Tel: 886-7-536-4818
Fax: 886-7-536-4803

台湾地区 - 台北
Tel: 886-2-2500-6610
Fax: 886-2-2508-0102

台湾地区 - 新竹
Tel: 886-3-572-9526
Fax: 886-3-572-6459

亚太地区

澳大利亚 Australia - Sydney
Tel: 61-2-9868-6733
Fax: 61-2-9868-6755

印度 India - Bangalore
Tel: 91-80-4182-8400
Fax: 91-80-4182-8422

印度 India - New Delhi
Tel: 91-11-4160-8631
Fax: 91-11-4160-8632

印度 India - Pune
Tel: 91-20-2566-1512
Fax: 91-20-2566-1513

日本 Japan - Yokohama
Tel: 81-45-471-6166
Fax: 81-45-471-6122

韩国 Korea - Daegu
Tel: 82-53-744-4301
Fax: 82-53-744-4302

韩国 Korea - Seoul
Tel: 82-2-554-7200
Fax: 82-2-558-5932 或
82-2-558-5934

马来西亚 Malaysia - Penang
Tel: 60-4-646-8870
Fax: 60-4-646-5086

菲律宾 Philippines - Manila
Tel: 63-2-634-9065
Fax: 63-2-634-9069

新加坡 Singapore
Tel: 65-6334-8870
Fax: 65-6334-8850

泰国 Thailand - Bangkok
Tel: 66-2-694-1351
Fax: 66-2-694-1350

欧洲

奥地利 Austria - Wels
Tel: 43-7242-2244-39
Fax: 43-7242-2244-393

丹麦 Denmark-Copenhagen
Tel: 45-4450-2828
Fax: 45-4485-2829

法国 France - Paris
Tel: 33-1-69-53-63-20
Fax: 33-1-69-30-90-79

德国 Germany - Munich
Tel: 49-89-627-144-0
Fax: 49-89-627-144-44

意大利 Italy - Milan
Tel: 39-0331-742611
Fax: 39-0331-466781

荷兰 Netherlands - Drunen
Tel: 31-416-690399
Fax: 31-416-690340

西班牙 Spain - Madrid
Tel: 34-91-708-08-90
Fax: 34-91-708-08-91

英国 UK - Wokingham
Tel: 44-118-921-5869
Fax: 44-118-921-5820

06/25/07